

	华晶分立器件	3CG966
	高频放大环境额定双极型晶体管	

1 概述与特点

3CG966 硅 PNP 型高频小功率晶体管，主要用于彩电电源振荡及低频放大电路。其特点如下：

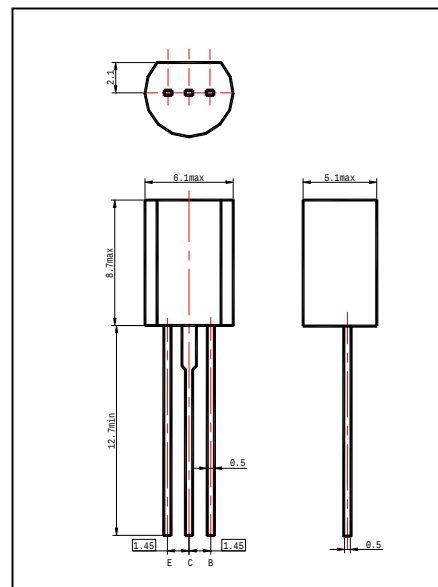
- 击穿电压低
- 饱和压降低
- 频率特性好
- 可靠性高
- 封装形式：TO-92MOD

2 电特性

2.1 极限值

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符号	额定值	单位
集电极-发射极电压	V_{CE0}	30	V
集电极-基 极电压	V_{CB0}	30	V
发射极-基 极电压	V_{EB0}	5	V
集电极电流	I_C	1.5	A
耗散功率	P_{tot}	0.9	W
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$



2.2 电参数

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

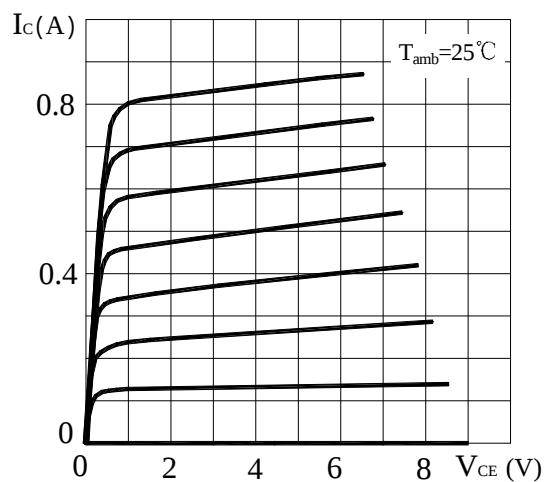
参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	$I_{CB0(1)}$	$V_{CB}=-30\text{V}, I_E=0$			0.1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$			0.1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=-2\text{V}$	O	100	200	
		$I_C=500\text{mA}$	Y	160	320	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\text{ sat}}$	$I_C=1.5\text{A}, I_B=30\text{mA}$			2	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=-2\text{V}, I_C=500\text{mA}$ $f=30\text{MHz}$	100			MHz
集电极输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0$ $f=1\text{MHz}$			40	PF

无锡华晶微电子股份有限公司

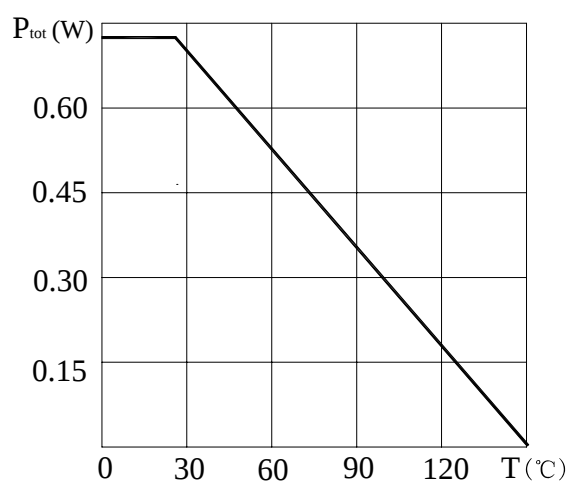
地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话：(0510)5807228-2268、2299 传真：(0510)5800360

3 特性曲线

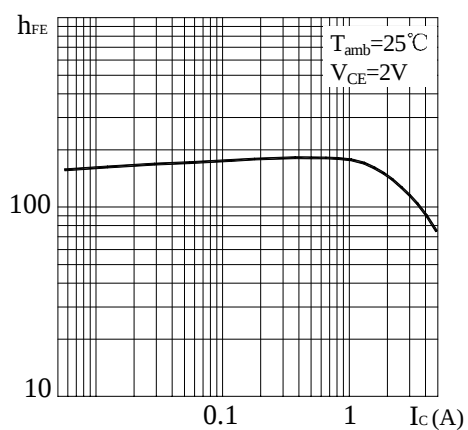
I_C - V_{CE} 关系曲线



P_{tot} - T_{amb} 关系曲线



h_{FE} - I_C 关系曲线



V_{CEsat} - I_C 关系曲线

